1000 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

LCRES-R1000OHM — 1000 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip.

Widerstand: 1000 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.04 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.08 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.



Elektrische Kenndaten TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Anzahl der Widerstände	-	-	-	-	1	-
Anzahl der Anschlüsse	-	-	-	-	2	-
Widerstand	-	-	1000	-	-	Ω
Widerstandstoleranz	-	-	±5	-	-	%
Linearer Betriebsstrom	-	-	0.04	-	-	A

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximal zulässiger Strom	-	-	-	0.08	A

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C

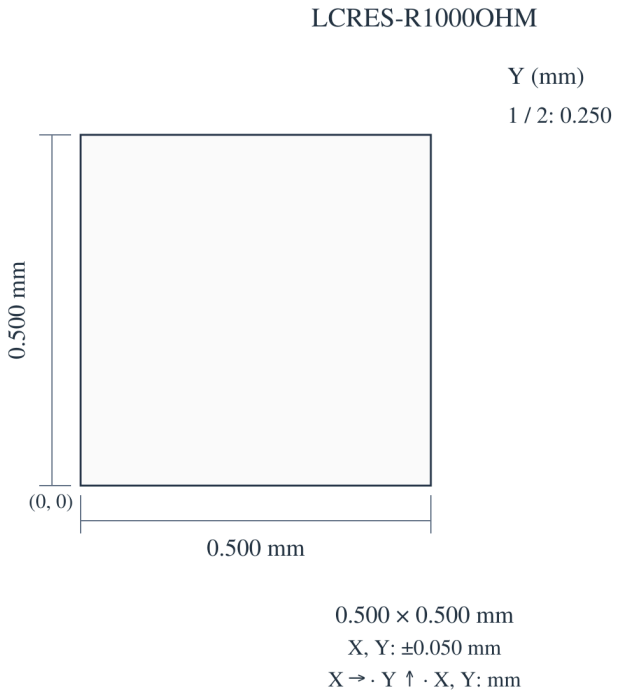
Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
1, 2	IN/OUT	Reziproker Ein-/Ausgang	-
Chiprückseite	GND	Masse	RF / DC GND

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen in der Draufsicht	0.5 × 0.5	mm

Maßskizze mit ausgewählten Abmessungen in mm. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.



Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Die Chiprückseite muss gut geerdet sein.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.